

Поз. обозначение		Наименование			Кол.	Примеч.			
		<u>Диоды</u>							
VD1, VD3		15SQ045 (Dongguan YFW, Кумаї)			2				
VD2		1N4002 (Diotec Semiconductor, Германия)			1				
		<u>Конденсаторы</u>							
C4		K10-17Б X5R 1000нФ 50В (Murata Electronics, Япония)			1				
C7		K10-17Б X5R 220нФ 50В (Murata Electronics, Япония)			1				
C6		K73-17 0,68мкФ 250В			1				
		(Кузнецкий завод конденсаторов, Россия)							
C2, C8		K50-35 2200мкФ 35В (JB Capacitors, Гонконг)			2				
C1, C3		K50-35 мини 47мкФ 50В (JB Capacitors, Гонконг)			2				
C5		K50-35 100мкФ 63В (JB Capacitors, Гонконг)							
		<u>Разъёмы</u>							
XS1		Гнездо стерео 3,5мм ST-025			1				
		(Dragon City Industries, Кумаї)							
XP1		Клеммник разъёмный 15EDGRC-3.81-03P (Degson, Кумаї)			1				
XP2		Клеммник разъёмный 15EDGRC-3.81-03P (Degson, Кумаї)			1				
		<u>Резисторы</u>							
R5, R9, R16		CF-25 0,25Вт 4.7кОм ±5%			3				
R7, R11, R15, R17, R18		CF-25 0,25Вт 6800Ом ±5%			5				
R2, R4		CF-25 0,25Вт 3кОм ±5%			2				
R6		CF-25 0,25Вт 15кОм ±5%			1				
					ИЧ4.11.03.03.23.05.52.04.001 ПЗЗ				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Бакулевский				Усилитель низкой частоты Перечень элементов		Лит.	Лист	Листов
Пров.	Семенов С. Г.							1	2
							МГТУ им Н.Э. Баумана Кафедра ИЧ4 Группа ИЧ4 – 52Б		
Н. контр.									
Утв.									

[illegible]